



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA94

对应国外型号
KSP94

主要用途

高压控制应用

极限值 ($T_a=25^\circ C$)

T_{stg} ——贮存温度 -55~150

T_j ——结温 150

P_c ——集电极耗散功率 625 mW

V_{CBO} ——集电极—基极电压 -400V

V_{CEO} ——集电极—发射极电压 -400V

V_{EBO} ——发射极—基极电压 -6V

I_c ——集电极电流 -300mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ C$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-400			V	$I_C=-100 \mu A, I_E=0$
BV_{CES}	集电极—发射极击穿电压	-400			V	$I_C=-100 \mu A, V_{BE}=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_E=-10 \mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-300V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-4V, I_C=0$
I_{CES}	集电极—发射极截止电流			-1	μA	$V_{CE}=-400V, V_{BE}=0$
h_{FE}	直流电流增益	40				$V_{CE}=-10V, I_C=-1mA$
		60		300		$V_{CE}=-10V, I_C=-10mA$
		45				$V_{CE}=-10V, I_C=-50mA$
		40				$V_{CE}=-10V, I_C=-100mA$
$V_{CE(sat)1}$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$
$V_{CE(sat)2}$				-0.75	V	$I_C=-50mA, I_B=-5mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			-0.75	V	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$
C_{ob}	共基极输出电容			7	pF	$V_{CB}=-20V, I_E=0, f=1MHz$